

Porte-Wafer En Silicium Ptfé Pour Processus De Gravure À L'acide Et De Nettoyage 2 4 6 8 Pouces Personnalisable Résistant Aux Hautes Températures

Numéro d'article: PL-CP158



Introduction

Porte-wafers en silicium PTFE de haute pureté conçus pour les processus extrêmes de gravure à l'acide et de nettoyage. Optimisés pour des wafers de 2 à 8 pouces, ces porte-substrats robustes et personnalisables assurent une manipulation sans contamination et une stabilité thermique dans les environnements de fabrication de semi-conducteurs les plus exigeants pour les achats B2B.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Gravure de semi-conducteurs	Manipulation de wafers dans des solutions d'HF concentré ou de BOE (gravure d'oxyde tamponnée) pour éliminer les couches diélectriques.	Une résistance exceptionnelle aux acides agressifs assure la durabilité à long terme du porte-substrat.
Processus de nettoyage RCA	Utilisation de solutions SC-1 et SC-2 à haute température pour éliminer les contaminants organiques et métalliques.	La stabilité thermique élevée empêche la déformation lors des bains oxydants à haute température.
Production de cellules photovoltaïques	Texturation et nettoyage de wafers en silicium lors de la fabrication de cellules solaires à haut rendement.	La conception robuste gère des débits industriels à grand volume avec une fiabilité constante.
Fabrication MEMS	Maintien sécurisé des substrats lors de processus complexes de gravure ionique réactive profonde et de libération humide.	Les fentes usinées avec précision protègent les structures micromécaniques délicates contre les dommages de contact.
Nettoyage par gravure Piranha	Traitement de wafers dans un mélange d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène pour éliminer les organiques lourds.	Les matériaux sont immunisés contre les attaques oxydantes fortes, empêchant la dégradation de l'équipement.
Recherche en nanotechnologie	Manipulation spécialisée de substrats personnalisés dans des dépôts chimiques en phase vapeur expérimentaux ou des traitements en phase liquide.	La personnalisation complète permet de prendre en charge des tailles de wafers non standard et des géométries uniques.
Assemblage optoélectronique	Nettoyage de wafers de saphir ou d'arséniure de gallium (GaAs) avant la croissance épitaxiale ou le dépôt de couches minces.	La pureté du matériau PTFE élimine le risque d'interférence de métaux traces dans les dispositifs optiques.

Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP158	Disponibilité/Options
Série de modèles	Porte-wafer en silicium PL-CP158	Conceptions standard et personnalisées
Matériau principal	PTFE de haute pureté (Polytétrafluoroéthylène)	Options PFA disponibles sur demande
Tailles de wafers compatibles	2 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces	Totalement personnalisable à tout diamètre
Configuration des fentes	La capacité et le pas sont définis par projet	Personnalisé selon les spécifications de l'utilisateur
Plage de température	Fonctionnement des niveaux cryogéniques à 260°C	Personnalisation dépendante du processus
Résistance chimique	Toute la gamme d'acides, de bases et de solvants	Compatibilité chimique universelle
Méthode de fabrication	Usinage de précision CNC 5 axes	Géométrie sur mesure disponible

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP158	Disponibilité/Options
Fonctionnalités de drainage	Ports de drainage inférieurs/latéraux personnalisables	Optimisé pour des débits de bain spécifiques
Conception de la poignée	Poignées manuelles/robotiques détachables ou intégrées	Personnalisé pour la compatibilité des outils
Niveau de pureté	Analyse de traces et qualité semi-conducteur	Matériaux de haute pureté certifiés